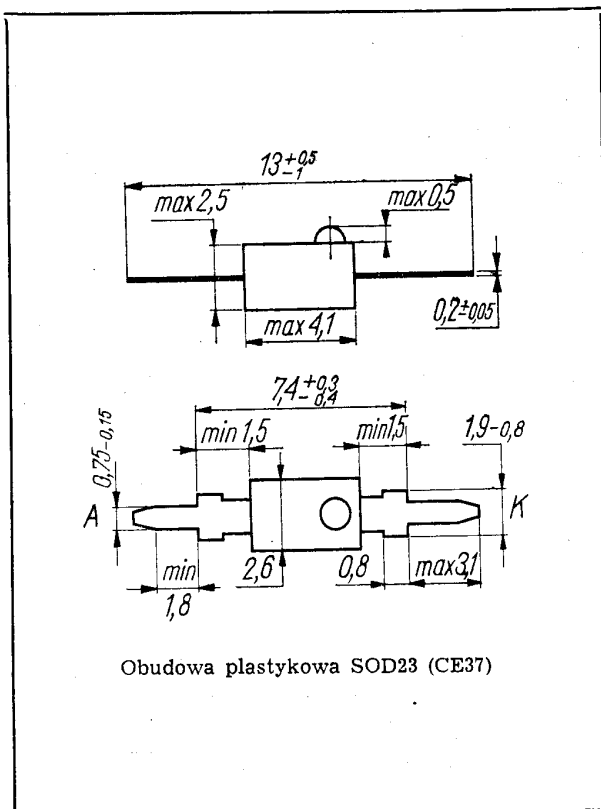


DIODY IMPULSOWE
*** BAP794, BAP794A, BAP795, BAP795A**

6-74/2

SWW 1156-131

Diody krzemowe epiplanarne są przeznaczone głównie do stosowania w bardzo szybkich układach przełączających oraz jako diody ogólnego zastosowania.



DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne wartości parametrów eksploatacyjnych

		BAP-			
		-794	-794A	-795	-795A
Napięcie wsteczne	U_R	25	30	50	50
Szczytowe napięcie wsteczne	U_{RM}	35	40	75	75
Średni prąd przewodzenia	I_F		80		
Szczytowy prąd przewodzenia ($f \geq 50$ Hz)	I_{FM}		180		
Prąd przeciążeniowy	I_{FSM}		800		
Moc całkowita	P_{tot}		200		
Temperatura złącza	t_j		393 K (125°C)		
Zakres temperatury składowania	t_{stg}	213...393 K (-55...+125°C)			

Dioda BAP794

Parametry statyczne; $t_{amb} = 298$ K (25°C)

		min.	typ.	maks.	
Napięcie przewodzenia przy $I_F = 30$ mA	U_F	—	0,84	1	V
Napięcie przebicia przy $I_R = 5$ μ A	U_{BR}	35	55	—	V
Prąd wsteczny przy $U_R = 25$ V	I_R	—	5	100	nA

Parametry dynamiczne; $t_{amb} = 298$ K (25°C)

Czas ustalania charakterystyki wstecznej przy $I_F = 10$ mA; $U_R = 6$ V; $R_L = 100$ Ω ; $i_{rr} = 1$ mA		t_{rr}	—	1	2
					ns
Pojemność diody przy $f = 1$ MHz; $U_R = 0$		C_T	—	1	4
					pF

Dioda BAP794A

Parametry statyczne; $t_{amb} = 298$ K (25°C)

		min.	typ.	maks.	
Napięcie przewodzenia przy $I_F = 2$ mA	U_F	0,62	0,66	0,7	V
Napięcie przebicia przy $I_R = 5$ μ A	U_{BR}	40	85	—	V
Prąd wsteczny przy $U_R = 30$ V	I_R	—	5	50	nA

Parametry dynamiczne; $t_{amb} = 298$ K (25°C)

		min.	typ.	maks.	
Czas ustalania charakterystyki wstecznej przy $I_F = 10$ mA; $U_R = 6$ V; $R_L = 100$ Ω ; $i_{rr} = 1$ mA		t_{rr}	—	1	2
					ns
Pojemność diody przy $f = 1$ MHz; $U_R = 0$		C_T	—	1	2
					pF

Dioda BAP795

Parametry statyczne; $t_{amb} = 298 \text{ K (25}^\circ\text{C)}$

		min.	typ.	maks.	
Napięcie przewodzenia					
przy $I_F = 50 \text{ mA}$	U_F	—	0,84	1	V
Napięcie przebicia					
przy $I_R = 5 \mu\text{A}$	U_{BR}	75	100	—	V
Prąd wsteczny					
przy $U_R = 50 \text{ V}$	I_R	—	8	50	nA

Parametry dynamiczne; $t_{amb} = 298 \text{ K (25}^\circ\text{C)}$

		min.	typ.	maks.	
Czas ustalania charak- terystryki wstecznej					
przy $I_F = 10 \text{ mA};$ $U_R = 6 \text{ V};$ $R_L = 100 \Omega;$ $i_{rr} = 1 \text{ mA}$	t_{rr}	—	1	2	ns
przy $I_F = 10 \text{ mA};$ $I_R = 10 \text{ mA};$ $i_{rr} = 1 \text{ mA}$		—	—	4	ns
Pojemność diody					
przy $f = 1 \text{ MHz};$ $U_R = 0$	C_T	—	1	2	pF

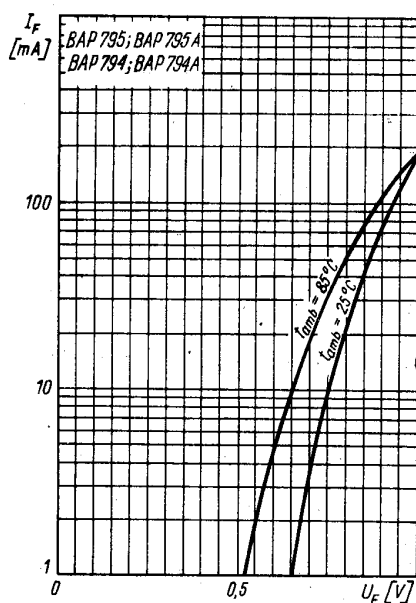
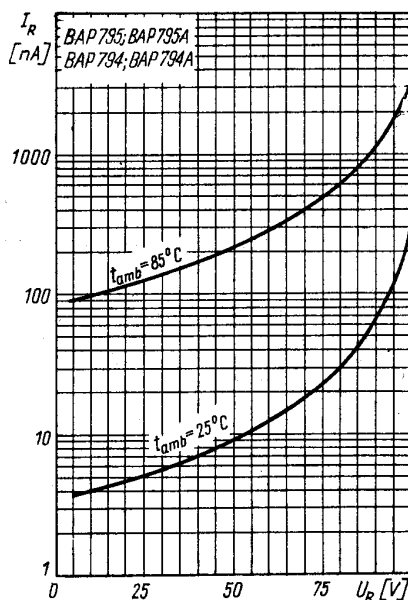
Dioda BAP795A

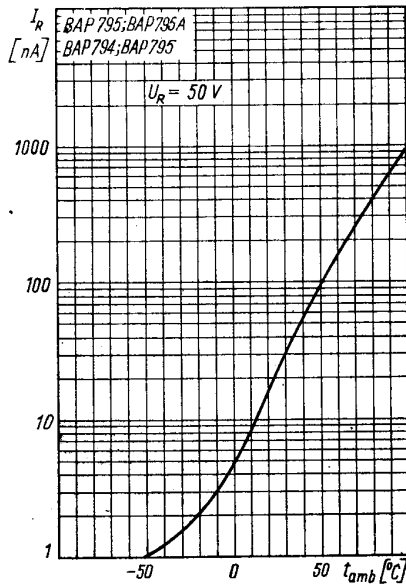
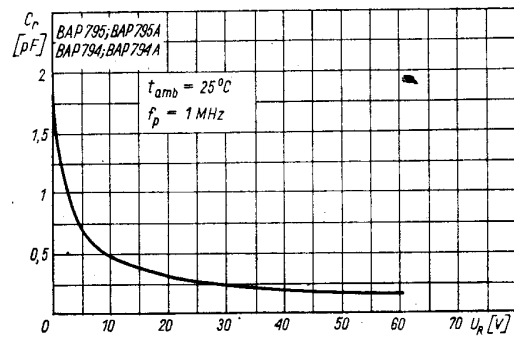
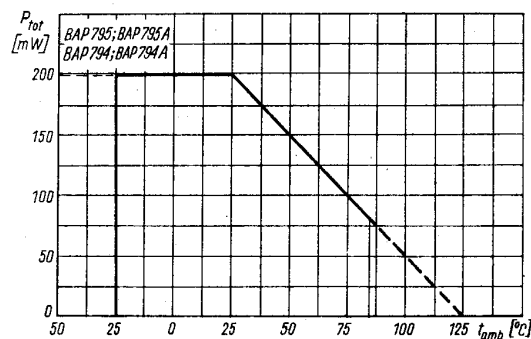
Parametry statyczne; $t_{amb} = 298 \text{ K (25}^\circ\text{C)}$

		min.	typ.	maks.	
Napięcie przewodzenia					
przy $I_F = 10 \text{ mA}$	U_F	0,7	0,76	0,81	V
Napięcie przebicia					
przy $I_R = 5 \mu\text{A}$	U_{BR}	75	100	—	V
Prąd wsteczny					
przy $U_R = 50 \text{ V}$	I_R	—	10	50	nA

Parametry dynamiczne; $t_{amb} = 298 \text{ K (25}^\circ\text{C)}$

		min.	typ.	maks.	
Czas ustalania charak- terystryki wstecznej					
przy $I_F = 10 \text{ mA};$ $U_R = 6 \text{ V};$ $R_L = 100 \Omega;$ $i_{rr} = 1 \text{ mA}$	t_{rr}	—	1	2	ns
przy $I_F = 10 \text{ mA};$ $I_R = 10 \text{ mA};$ $i_{rr} = 1 \text{ mA}$		—	—	4	ns
Pojemność diody					
przy $f = 1 \text{ MHz};$ $U_R = 0$	C_T	—	1	2	pF

Prąd przewodzenia w funkcji napięcia przewodzenia $I_F = f(U_F)$ Prąd wsteczny w funkcji napięcia wstecznego
 $I_R = f(U_R)$

Prąd wsteczny w funkcji temperatury $I_R = f(t_{amb})$ Zmiany pojemności w funkcji napięcia wstecznego $C_r = f(U_R)$ Charakterystyka mocy w funkcji temperatury oświetlenia $P_{tot} = f(t_{amb})$

PRODUCENT

NAUKOWO-PRODUKCYJNE
CENTRUM PÓLPRZEWODNIKÓW

ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 43 14 31 ÷ 39
Teleks: 813 219

DYSTRYBUTOR

BIURO ZBYTU SPRZĘTU
TELERADIOTECHNICZNEGO

ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefony: 28 94 11; 28 64 74
Teleks: 813 435